

電磁理論 IA&IB ミニツレポート B②	2011 年 6 月 8 日	学籍番号	氏名	評点
--------------------------	----------------	------	----	----

(真空中の電磁界基本法則 I)

(1) 半径 a の円柱状一様な定常電流(電流密度 $\mathbf{J} = j_z \hat{z}$) が軸方向に流れている。以下に答えよ。

1.1 アンペアの周回積分の法則(積分形)を記述せよ。

$$\oint_C \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS \quad \left(\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS \text{ 也一样} \right)$$

1.2 1.1 の法則を用いて円柱内外の磁束密度 $\mathbf{B}$ を求めよ。また $|\mathbf{B}|$ を図示せよ

z 軸方向無限長の定常電流 $\mathbf{J} = j_z \hat{z}$ の円柱対称系系中 $\mathbf{B}$ は φ 方向成分 B_φ のみで r が同じ B_φ は一定。 $\therefore \mathbf{B} = B_\varphi \hat{\varphi}$, $d\mathbf{l} = \hat{\varphi} r d\varphi = \hat{\varphi} r d\varphi$, $\mathbf{n} = \hat{z}$, $\mathbf{n} dS = dS \hat{z} = dr d\varphi \hat{z}$ (より)

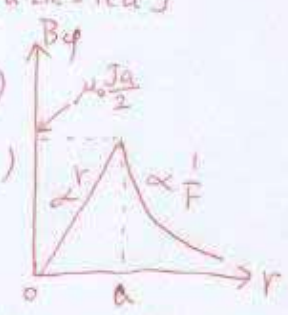
1.1 の法則において 半径 r の周回を考えて $\mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B_\varphi \hat{\varphi} \cdot \hat{\varphi} r d\varphi = B_\varphi r d\varphi$, $\mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS = j_z \hat{z} \cdot \hat{z} r dr d\varphi = j_z r dr d\varphi$

左辺 $= \oint_C \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} \frac{B_\varphi}{\mu_0} r d\varphi = \frac{B_\varphi r}{\mu_0} [\varphi]_0^{2\pi} = 2\pi r \frac{B_\varphi}{\mu_0}$

右辺は $r < a$ のとき $\int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^r j_z r dr d\varphi = j_z [\frac{1}{2} r^2]_0^r [\varphi]_0^{2\pi} = j_z \cdot \frac{1}{2} r^2 \cdot 2\pi = \pi r^2 j_z$

$r \geq a$ のとき $\int_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^a j_z r dr d\varphi = j_z [\frac{1}{2} r^2]_0^a [\varphi]_0^{2\pi} = j_z \cdot \frac{1}{2} a^2 \cdot 2\pi = \pi a^2 j_z$

$\therefore \frac{2\pi r B_\varphi}{\mu_0} = \begin{cases} \pi r^2 j_z & (r < a) \\ \pi a^2 j_z & (r \geq a) \end{cases} \therefore B_\varphi = \begin{cases} \mu_0 \frac{j_z r}{2} & (r < a) \\ \mu_0 \frac{j_z a^2}{2r} & (r \geq a) \end{cases} \therefore \mathbf{B} = \begin{cases} \hat{\varphi} \mu_0 \frac{j_z r}{2} & (r < a) \\ \hat{\varphi} \mu_0 \frac{j_z a^2}{2r} & (r \geq a) \end{cases}$



1.3 全電流 I とするとき, I を用いて $\mathbf{B}$ を表せ。

$I = \pi a^2 j_z \therefore j_z = \frac{I}{\pi a^2} \therefore \mathbf{B} = \begin{cases} \hat{\varphi} \mu_0 \frac{I}{2\pi a^2} r & r \leq a \\ \hat{\varphi} \mu_0 \frac{I}{2\pi r} & r \geq a \end{cases}$ ($r=0$ は I の電流が流れる場合と等価)

(2) 半径 a のシート状(厚さゼロ)円筒静止電荷分布(面電荷密度 $\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$)がある。次に答えよ。

2.1 電束に関するガウスの法則(積分形)を記述せよ。電荷密度 $\rho[\text{C}/\text{m}^3]$ を用いて表現せよ。

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \rho dV \quad \left(\oint_S \epsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \rho dV \text{ 也一样} \right)$$

2.2 上記の法則を用いて円筒内外の電界 $\mathbf{E}$ を求めよ。また $|\mathbf{E}|$ の r 方向分布を図示せよ。

但し, $\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ を使用せよ。

z 軸方向無限長の円柱対称系電界 $\mathbf{E}$ は r 成分 E_r のみで r が同じ E_r は同じ

$\therefore \mathbf{D} = \hat{r} \epsilon_0 E_r(r)$, $\mathbf{n} dS = dS \hat{r} = dr d\varphi dz \hat{r}$ 又 $dV = d\mathbf{l}_r \cdot (d\mathbf{l}_\varphi \times d\mathbf{l}_z) = r dr d\varphi dz$

2.1 の法則より 半径 r の円柱 (z 方向長 1) を考えて $\mathbf{D} \cdot \mathbf{n} dS = \hat{r} \epsilon_0 E_r(r) \cdot \hat{r} r d\varphi dz = \epsilon_0 E_r(r) r d\varphi dz$

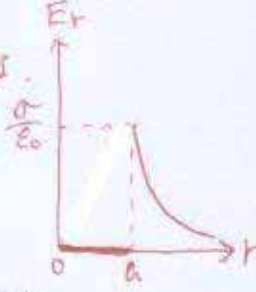
左辺 $= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \epsilon_0 E_r(r) r d\varphi dz = \epsilon_0 E_r(r) [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^1 = 2\pi r \epsilon_0 E_r(r)$

右辺において 電荷は $r=a$ にしか存在しないので $dV = r dr d\varphi dz$ は $a dy dz \leq z \leq 1$

$r < a$ において 右辺 $= \int_0^1 \int_0^{2\pi} 0 a d\varphi dz = 0$

$r \geq a$ において 右辺 $= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \sigma a d\varphi dz = \sigma a [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^1 = 2\pi \sigma a$

$\therefore 2\pi r \epsilon_0 E_r(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ 2\pi \sigma a & (r \geq a) \end{cases} \therefore E_r(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r} & (r \geq a) \end{cases} \therefore \mathbf{E} = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \hat{r} \frac{\sigma a}{\epsilon_0 r} & (r \geq a) \end{cases}$



2.3 z 軸方向単位長さ当りの全電荷を q とするとき, q を用いて $\mathbf{E}$ を表せ。

$q = 2\pi a \cdot 1 \cdot \sigma = 2\pi \sigma a \therefore \sigma = \frac{q}{2\pi a}$

$\therefore \mathbf{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \hat{r} \frac{q}{2\pi \epsilon_0 r} & r \geq a \end{cases}$ ($r=0$ は単位長さ当りの電荷 q が存在する場合と等価)

(3) 電荷保存の法則(積分形)を記述せよ。

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dS = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV$$